

PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用

PNP Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

○オーディオアンプ等のドライバ段に最適です。

○小形で P_T が大きく、高耐圧です。

$$P_T = 1.0 \text{ W}, V_{CE0} = -50 \text{ V}$$

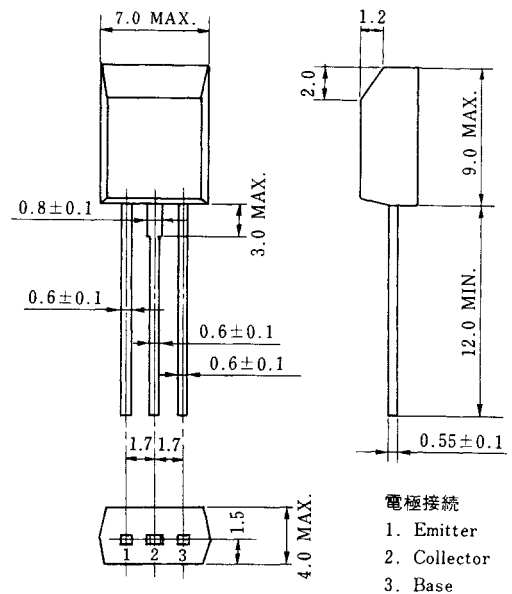
○2SD774とコンプリメンタリで使用できます。

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-6.0	V
コレクタ電流 (直流)	$I_{C(DC)}$	-1.0	A
全損失	P_T	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS

(Unit : mm)



電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

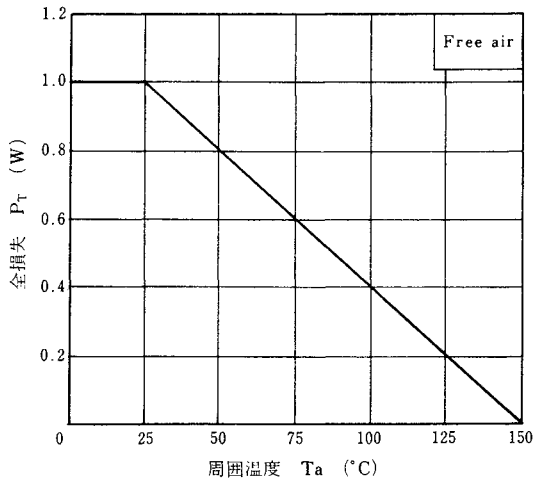
項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -50 \text{ V}, I_E = 0$			-100	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -6.0 \text{ V}, I_C = 0$			-100	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -2.0 \text{ V}, I_C = -100 \text{ mA}$ *	135	250	600	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -1.0 \text{ V}, I_C = -1.0 \text{ A}$ *	40			
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -50 \text{ mA}$ *	-0.55	-0.6	-0.65	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -1.0 \text{ A}, I_B = -50 \text{ mA}$ *		-0.35	-0.6	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -1.0 \text{ A}, I_B = -50 \text{ mA}$ *		-0.94	-1.2	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10 \text{ V}, I_E = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$		23	50	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -2.0 \text{ V}, I_E = 10 \text{ mA}$	50	80		MHz

*パルス測定 $PW \leq 350 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ / Pulsed

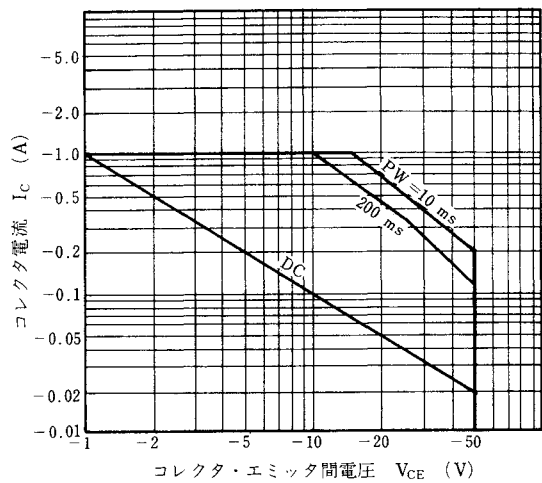
h_{FE1} 区分 / h_{FE1} Classification L2: 135~270 K3: 200~320 K4: 250~400 U4: 300~480 U5: 360~600

特性曲線 / TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

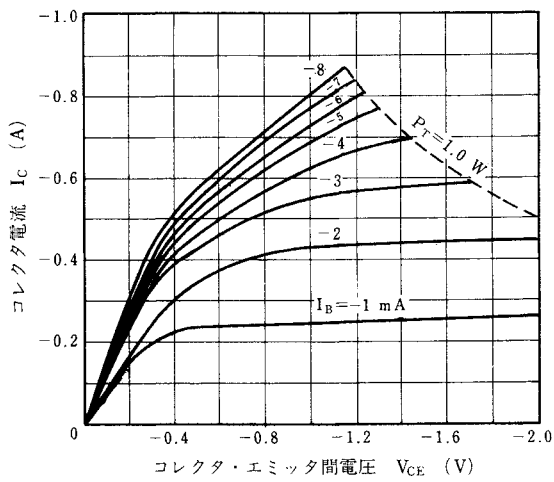
TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE



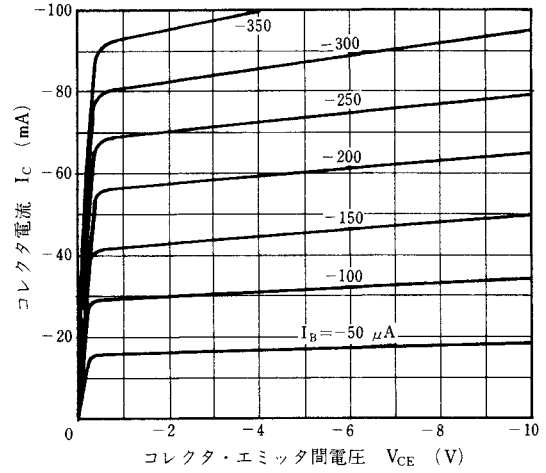
SAFE OPERATING AREAS (TRANSIENT THERMAL RESISTANCE METHOD)



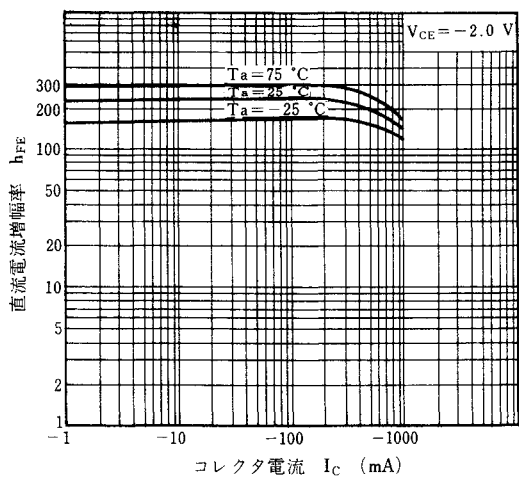
COLLECTOR CURRENT vs. COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE



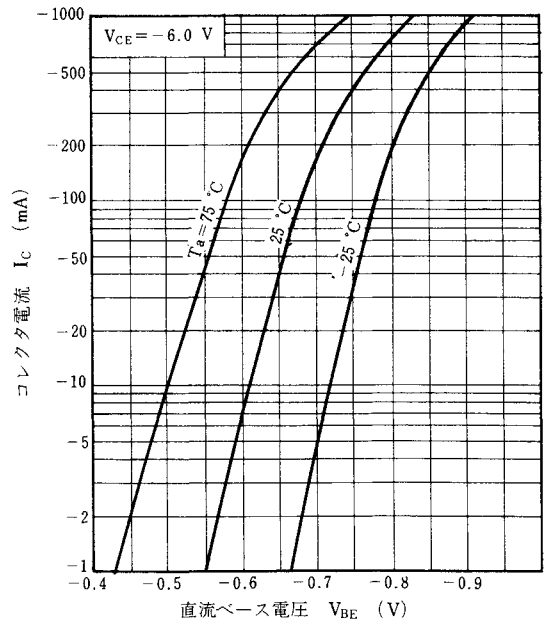
COLLECTOR CURRENT vs. COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE



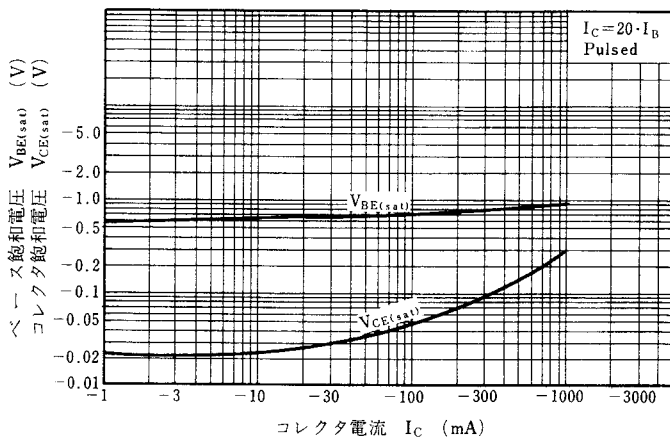
DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR CURRENT



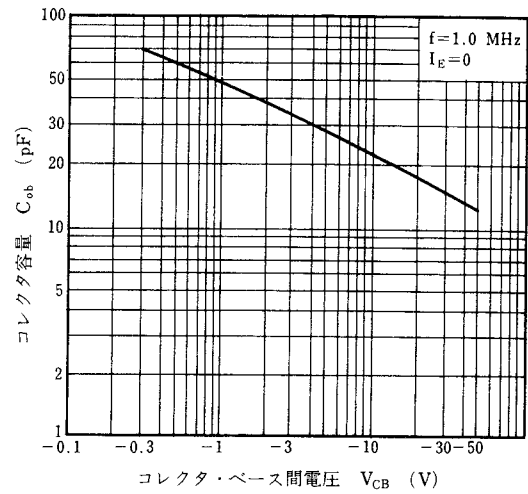
COLLECTOR CURRENT vs. BASE TO EMITTER VOLTAGE



BASE AND COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



OUTPUT CAPACITANCE vs. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT

